



长沙黄花国际机场 ----- 打车15分钟
长沙高铁南站 ----- 打车50分钟
长沙火车站 ----- 打车50分钟

浏阳泰科天润半导体技术有限公司

北京首都国际机场 ----- 打车30分钟
北京西站 ----- 打车90分钟
北京南站 ----- 打车90分钟

泰科天润半导体科技(北京)有限公司



公众号

地址：北京市顺义区文良街15号1号楼2层东侧

地址：湖南省浏阳市永安镇高新技术产业园永和南路新能源汽车零部件产业园18号

市场需求请联系：0731-81810988转8015 传真：010-82156218

邮箱：qiuqi@globalpowertech.cn

网址：<http://www.globalpowertech.cn>

SiC芯片/功率器件

SiC POWER DEVICES

泰科天润 >>2022

CONTENTS

>> 目录



P03 公司简介

关于我们-----03

资质认证-----04

发展历程-----05/06

6寸线概要-----07/08

P09 产品

碳化硅功率器件----09/10

应用领域-----11/12

P13 选型表

选型表-----13/17

联系我们-----18

泰科天润
碳化硅 6 英寸晶圆生产线

关于我们/About us

泰科天润半导体科技（北京）有限公司成立于2011年，是中国碳化硅功率器件产业化领军企业，专业从事碳化硅器件研发与制造，并提供应用解决方案。总部坐落于北京，拥有两条碳化硅半导体工艺晶圆生产线。泰科天润拥有一支尖端人才聚集的碳化硅研发生产团队，涵盖研发、设计、工艺、品控、制造5个方向。泰科天润是一家IDM模式企业，拥有11年碳化硅器件量产经验，产线已通过IATF16949体系认证。基于自有晶圆厂，泰科天润开发出先进特色工艺，并向市场推出了丰富的碳化硅器件产品，性能达到国际领先水平。

同时，公司建有可靠性实验室、器件评估实验室、失效分析实验室、系统应用实验室，为向客户提供优质产品提供有力保障。泰科天润的碳化硅产品已通过AEC-Q101、RoHS、REACH、UL等标准认证，产品质量比肩行业先进水平。产品规格范围覆盖650V-3300V（1A-100A）等多款规格，已批量应用于光伏逆变器、充电桩、OBC、车载DC-DC、通信电源、高端服务器电源、工业电源、PC电源等领域，并多次获得行业优秀产品奖。

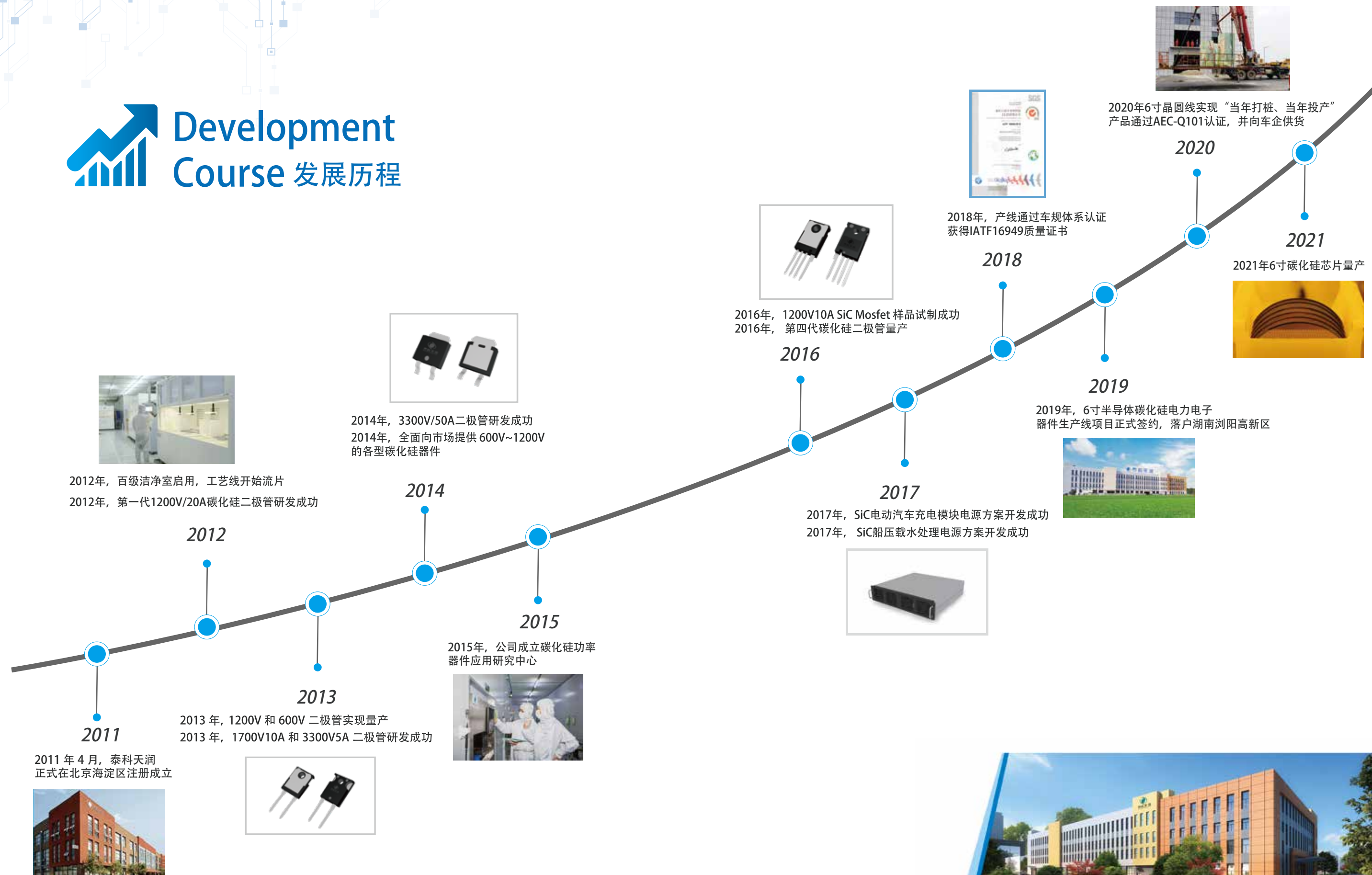


资质认证 / Certifications





Development Course 发展历程



>>> 碳化硅 6 英寸晶圆生产线

泰科天润6寸碳化硅晶圆产业园坐落于湖南省浏阳高新区，是湖南省重点引进落地项目。项目第一期投资5亿元，可实现产能6万片/年，年销售收入可达到10-15亿元。产线拥有碳化硅功率器件专用生产高端设备，包括高温离子注入机、高温退火炉、高温氧化炉、碳薄膜溅射台等，掌握全面的器件研发、工艺开发、生产制造能力。在泰科天润全体员工的共同努力下，实现了“当年打桩、当年投产”的泰科速度。泰科天润6寸碳化硅晶圆线现已向市场批量供货，实现了国产碳化硅功率半导体的自主控制，突破了行业领域技术壁垒，填补了国内产业空白。

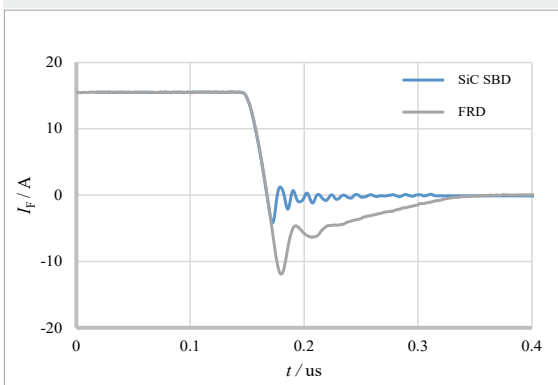


碳化硅功率器件

SIC POWER SEMICONDUCTOR DEVICES

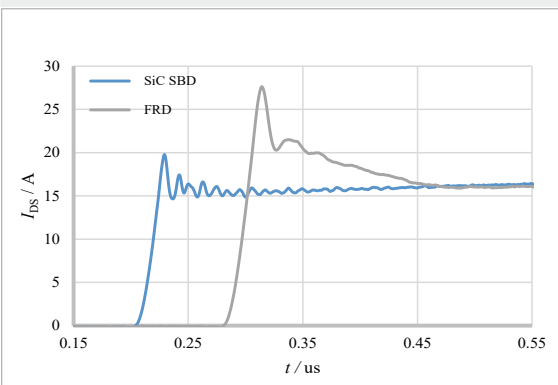
第三代半导体器件—碳化硅功率器件，拥有低导通电阻，高开关速度，高工作温度等优异特性，可广泛应用于功率控制和功率管理领域。与传统硅功率器件相比，使用碳化硅功率器件能提高系统效率，大幅减少系统体积，提高功率密度，是适应功率设备未来发展的最好选择。

在实际应用中，碳化硅肖特基二极管的反向恢复损耗远远低于快恢复二极管的损耗



反向恢复电流波形

实际应用中，二极管的关断过程往往对应着对应开关管的开通过程。使用碳化硅二极管后，其对应开关管的开通损耗大大降低



对管开通电流波形

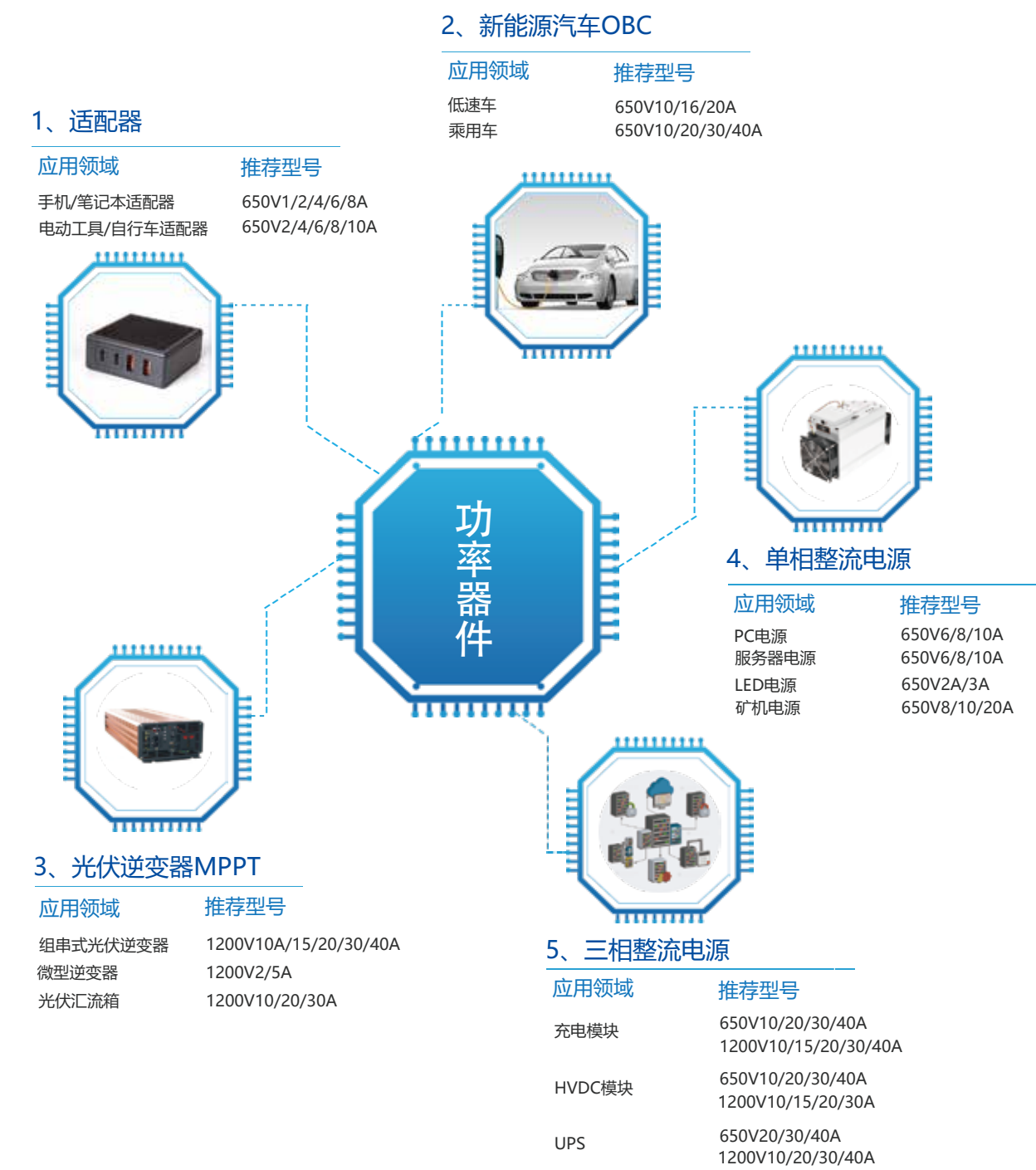
泰科天润的SiC器件产品覆盖650V/1200V/1700V/3300V (1A-100A)

封装：提供TO-220、TO-220全包封、TO-220内绝缘、TO-247-2L、TO-247-3L、TO-252、TO-263、DFN5*6、DFN8*8、SOD123、SMA等多款塑封以及高温封装形式，并按客户需求提供其他封装形式。

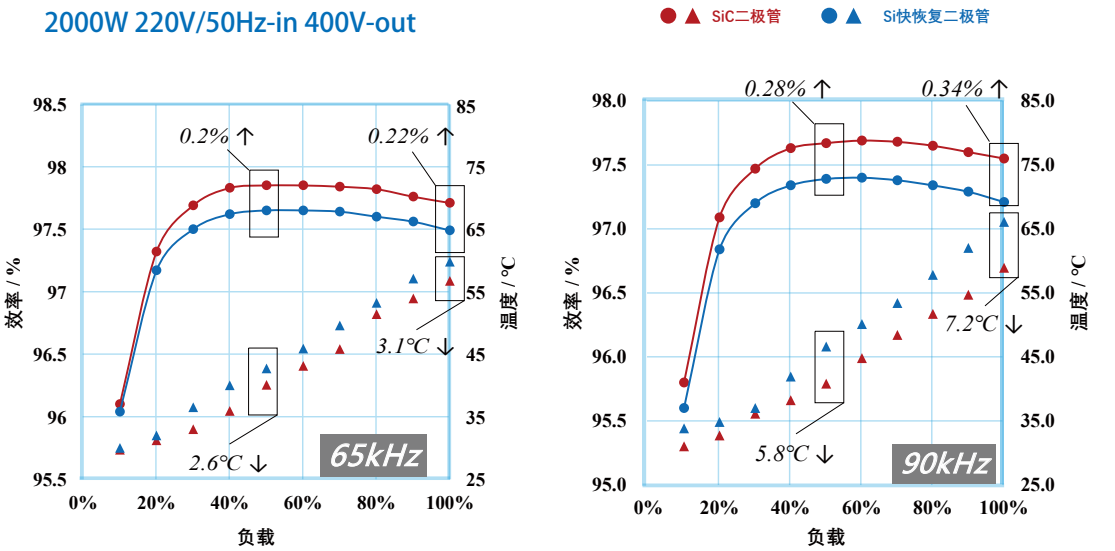
封装样式查询表：

TO-220AC	TO-220ISO	TO-220F	TO-247AB
TO-247AC	TO-263	TO-263左脚悬空	TO-252
TO-252左脚悬空	DFN8×8	DFN5×6	SOD123
SMA	SMD高温金属	9000V(1A/5A) 碳化硅高压硅堆模块	7000V(1A/5A) 碳化硅高压硅堆模块

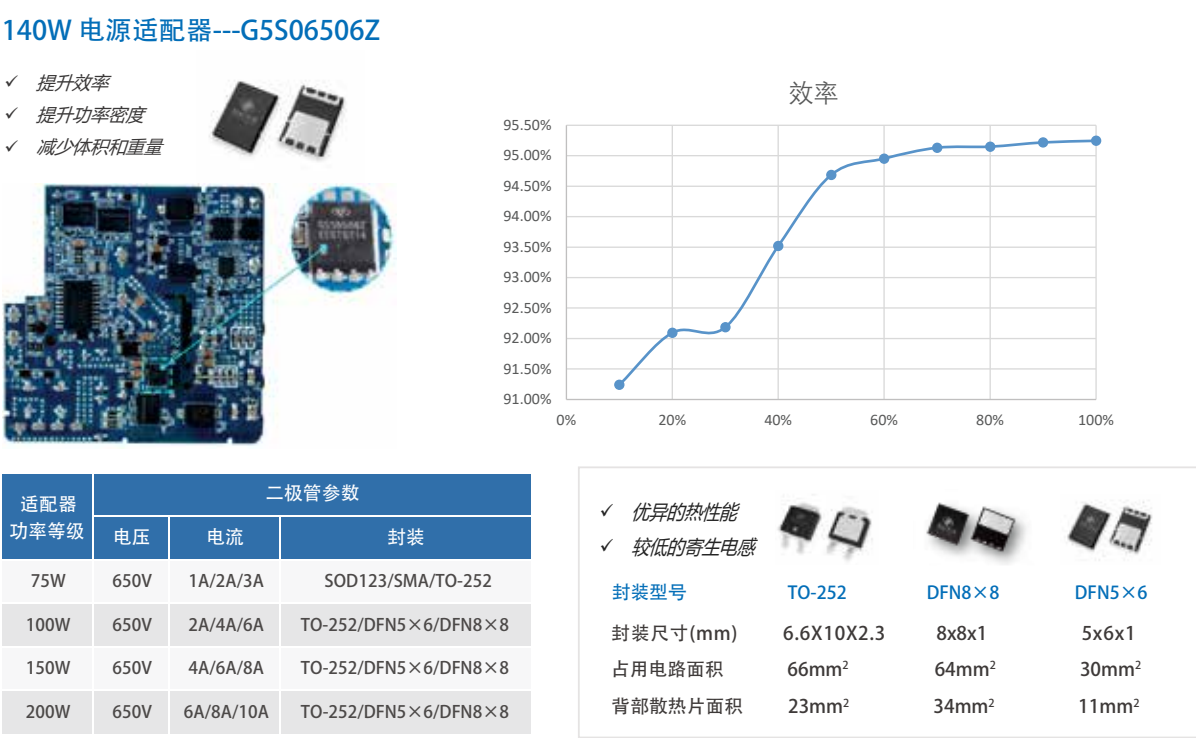
>>> 功率器件应用领域
Discrete device applications



Boost PFC 实测案例



SiC Diode在适配器上的应用



碳化硅器件选型表

料号	反向重复电压	正向平均电流	正向压降VF (V)		封装
		IF(A)	Tj=25℃		
ID	Vrrm(V)	Tc=160℃	typ	max	Package
G51XT	650	0.65(125℃)	1.38	1.6	SOD123
G52YT	650	2(140℃)	1.3	1.7	SMA
G53YT	650	3(125℃)	1.35	1.6	SMA
G21XT	1200	1(153℃)	1.35	1.7	SOD123
G3S06004J	600	4(143℃)	1.53	1.7	TO-220ISO
G3S06006J	600	6(149℃)	1.36	1.7	TO-220ISO
G3S06008J	600	8(144.5℃)	1.38	1.7	TO-220ISO
G3S06502A	650	2	1.37	1.7	T0-220AC
G3S06502C	650	2 (159℃)	1.37	1.7	TO-252
G3S06502D	650	2 (163℃)	1.37	1.7	T0-263
G3S06502H	650	2 (158℃)	1.37	1.7	T0-220F
G3S06502R	650	2 (159℃)	1.37	1.7	TO-252左脚悬空
G3S06504A	650	4(150℃)	1.53	1.7	T0-220AC
G3S06504C	650	4(149℃)	1.53	1.7	TO-252
G3S06504D	650	4 (157℃)	1.53	1.7	T0-263
G3S06504H	650	4(142℃)	1.53	1.7	T0-220F
G3S06504J	650	4 (149℃)	1.53	1.7	TO-220ISO
G3S06504R	650	4 (150℃)	1.53	1.7	TO-252左脚悬空
G3S06506A	650	6(158.5℃)	1.36	1.7	T0-220AC
G3S06506C	650	6(156.5℃)	1.36	1.7	TO-252
G3S06506D	650	6 (161℃)	1.43	1.7	T0-263
G3S06506H	650	6(145℃)	1.36	1.7	T0-220F
G3S06506J	650	6 (152℃)	1.43	1.7	TO-220ISO
G3S06506R	650	6 (157℃)	1.43	1.7	TO-252左脚悬空
G3S06506U	650	6 (161℃)	1.43	1.7	T0-263左脚悬空
G3S06508A	650	8(156.5℃)	1.38	1.7	T0-220AC
G3S06508C	650	8(153.5℃)	1.38	1.7	TO-252
G3S06508D	650	8(156℃)	1.38	1.7	T0-263
G3S06508H	650	8(134℃)	1.38	1.7	T0-220F
G3S06508J	650	8 (146℃)	1.38	1.7	TO-220ISO
G3S06508R	650	8 (155℃)	1.41	1.7	TO-252左脚悬空
G3S06510A	650	10(153.5℃)	1.39	1.7	T0-220AC
G3S06510C	650	10(150℃)	1.38	1.7	TO-252
G3S06510D	650	10(154℃)	1.39	1.7	T0-263
G3S06510H	650	10 (125℃)	1.39	1.7	T0-220F
G3S06510J	650	10 (154℃)	1.43	1.7	TO-220ISO
G3S06510K	650	10 (204℃)	1.43	1.7	SMD0.2
G3S06510L	650	10 (154℃)	1.43	1.7	TO-247AB-3L
G3S06510M	650	10 (133.5℃)	1.39	1.7	T0-220F
G3S06510P	650	10(152℃)	1.39	1.7	TO-247AC-2L
G3S06510R	650	10 (155℃)	1.43	1.7	TO-252左脚悬空
G3S06520A	650	20 (140℃)	1.52	1.7	T0-220AC
G3S06520H	650	12.6 (125℃)	1.52	1.7	T0-220F
G3S06520L	650	20 (145℃)	1.52	1.7	TO-247AB-3L
G3S06520P	650	20 (144℃)	1.5	1.7	TO-247AC-2L
G3S06520PM	650	20 (145℃)	1.52	1.7	TO-247AC-2L
GAS06520A	650	20(148.5℃)	1.38	1.7	T0-220AC

(附注： 3300V 0.6A/1A/2A/3A/5A/50A/1200V50A及单芯封装的管芯均可对模块用户提供)

碳化硅器件选型表

料号	反向重复电压	正向平均电流	正向压降VF (V)		封装
		IF(A)	Tj=25℃		
ID	Vrrm(V)	Tc=160℃	typ	max	Package
GAS06520A	650	20(148.5℃)	1.38	1.7	T0-220AC
GAS06520D	650	20(153.5℃)	1.38	1.7	T0-263
GAS06520H	650	15 (125℃)	1.38	1.7	T0-220F
GAS06520L	650	20 (154℃)	1.38	1.7	TO-247AB-3L
GAS06520P	650	20 (154℃)	1.38	1.7	TO-247AC-2L
G3S06530A	650	30(143℃)	1.41	1.7	T0-220AC
G3S06530L	650	30 (152℃)	1.44	1.7	TO-247AB-3L
G3S06530P	650	30 (152℃)	1.44	1.7	TO-247AC-2L
G3S06530PM	650	30(144.5℃)	1.41	1.7	TO-247AC-2L
G3S06550A	650	50 (151℃)	1.45	1.7	T0-220AC
G3S06550P	650	50 (136℃)	1.45	1.7	TO-247AC-2L
G3S06550PM	650	50 (143.5℃)	1.47	1.7	TO-247AC-2L
G3S065100P	650	100(135℃)	1.65	2.0	TO-247AC-2L
G3S06510B	650	5 ⁺ (162.5℃)	1.3	1.7	TO-247AB-3L
G3S06512B	650	6 ⁺ (159℃)	1.36	1.7	TO-247AB-3L
G3S06516B	650	8 ⁺ (154℃)	1.35	1.7	TO-247AB-3L
G3S06520B	650	10 ⁺ (153.5℃)	1.39	1.7	TO-247AB-3L
G3S06520BM	650	10* (154℃)	1.43	1.7	TO-247AB-3L
G3S06540B	650	20 ⁺ (144℃)	1.5	1.7	TO-247AB-3L
G3S06560B	650	30* (152℃)	1.44	1.7	TO-247AB-3L
GAS06540B	650	20* (154℃)	1.38	1.7	TO-247AB-3L
G3S06540PP	650	40 (148℃)	1.52	1.7	TO-247AC-2L
G4S06503AT	650	3 (154℃)	1.5	1.8	T0-220AC
G4S06503CT	650	3 (151℃)	1.5	1.8	TO-252
G4S06503HT	650	3 (145℃)	1.5	1.8	T0-220F
G4S06506AT	650	6 (127℃)	1.68	1.8	T0-220AC
G4S06506HT	650	5(125℃)	1.68	1.8	T0-220F
G4S06506CT	650	6(142℃)	1.68	1.8	TO-252
G4S06506RT	650	6(142℃)	1.68	1.8	TO-252
G4S06508AT	650	8 (153℃)	1.4	1.7	T0-220AC
G4S06508CT	650	8 (153℃)	1.4	1.7	TO-252
G4S06508RT	650	8 (153℃)	1.4	1.7	TO-252
G4S06508DT	650	8 (152℃)	1.4	1.7	T0-263
G4S06508HT	650	8(140℃)	1.4	1.7	T0-220F
G4S06508JT	650	8 (151.5℃)	1.4	1.7	TO-220ISO
G4S06508QT	650	8 (159℃)	1.4	1.7	DFN8*8
G4S6508Z	650	8 (158℃)	1.4	1.7	DFN5*6
G4S06510AT	650	10 (151℃)	1.38	1.7	T0-220AC
G4S06510CT	650	10 (153℃)	1.38	1.7	TO-252
G4S06510DT	650	10 (153℃)	1.38	1.7	T0-263
G4S06510HT	650	10 (133℃)	1.38	1.7	T0-220F
G4S06510JT	650	10 (153℃)	1.38	1.7	TO-220ISO
G4S06510PT	650	10 (153℃)	1.38	1.7	TO-247AC-2L
G4S06510QT	650	10	1.38	1.7	DFN8*8
G4H06510AT	650	10 (143.5℃)	1.5	1.7	T0-220AC
G4H06510HT	650	10 (106℃)	1.5	1.7	T0-220AC
G4H06510DT	650	10 (142℃)	1.5	1.7	TO-263

(附注： 3300V 0.6A/1A/2A/3A/5A/50A/1200V50A及单芯封装的管芯均可对模块用户提供)

碳化硅器件选型表

料号	反向重复电压	正向平均电流	正向压降VF (V)		封装
		IF(A)	Tj=25℃		
ID	Vrrm(V)	Tc=160℃	typ	max	Package
G4S06515AT	650	15 (143℃)	1.5	1.7	T0-220AC
G4S06515CT	650	15 (143℃)	1.5	1.7	TO-252
G4S06515DT	650	15 (145℃)	1.5	1.7	T0-263
G4S06515HT	650	12.5 (125℃)	1.5	1.7	T0-220F
G4S06515PT	650	15 (145℃)	1.5	1.7	TO-247AC-2L
G4S06515QT	650	15 (156℃)	1.5	1.7	DFN8*8
G4S06515LT	650	15 (145℃)	1.5	1.7	TO-247AB-3L
G4S06512BT	650	6* (139℃)	1.68	1.8	TO-247AB-3L
G4S06516BT	650	8*(154℃)	1.4	1.7	TO-247AB-3L
G4S06520BT	650	10* (153℃)	1.38	1.7	TO-247AB-3L
G4S06530BT	650	15* (145℃)	1.5	1.7	TO-247AB-3L
G4S06540PT	650	40 (133℃)	1.46	1.7	TO-247AC-2L
G5S06502AT	650	2 (161℃)	1.3	1.5	T0-220AC
G5S06502CT	650	2	1.3	1.5	TO-252
G5S06504AT	650	4 (150℃)	1.4	1.6	T0-220AC
G5S06504CT	650	4 (156℃)	1.4	1.6	TO-252
G5S06504HT	650	4 (145℃)	1.4	1.6	T0-220F
G5S06504QT	650	4 (161℃)	1.4	1.6	DFN8*8
G5S6504Z	650	4 (152℃)	1.4	1.6	DFN5*6
G5S06505AT	650	5 (162℃)	1.23	1.5	T0-220AC
G5S06505CT	650	5 (162℃)	1.23	1.5	TO-252
G5S06505DT	650	5 (161℃)	1.23	1.5	T0-263
G5S06505HT	650	5 (157℃)	1.23	1.5	T0-220F
G5S06506AT	650	6	1.3	1.5	T0-220AC
G5S06506CT	650	6	1.3	1.5	TO-252
G5S06506DT	650	6 (157℃)	1.3	1.5	T0-263
G5S06506HT	650	6 (152℃)	1.3	1.5	T0-220F
G5S06506QT	650	6 (163℃)	1.3	1.5	DFN8*8
G5S6506Z	650	6 (158.5 ℃)	1.3	1.5	DFN5*6
G5S06508AT	650	8 (157℃)	1.3	1.5	T0-220AC
G5S06508CT	650	8 (157℃)	1.3	1.5	TO-252
G5S06508DT	650	8 (158℃)	1.3	1.5	T0-263
G5S06508HT	650	8 (145℃)	1.3	1.5	T0-220F
G5S06508PT	650	8 (157℃)	1.3	1.5	TO-247AC-2L
G5S06508QT	650	8 (163℃)	1.3	1.5	DFN8*8
G5S06510AT	650	10 (156℃)	1.3	1.5	T0-220AC
G5S06510CT	650	10 (156℃)	1.3	1.5	TO-252
G5S06510DT	650	10 (157℃)	1.3	1.5	T0-263
G5S06510HT	650	10 (140℃)	1.3	1.5	T0-220F
G5S06510PT	650	10 (157℃)	1.3	1.5	TO-247AC-2L
G5S06510QT	650	10 (162℃)	1.3	1.5	DFN8*8
G5S06520AT	650	20 (155℃)	1.3	1.5	T0-220AC
G5S06520BT	650	10* (155℃)	1.3	1.5	TO-247AB-3L
G3S12002A	1200	2 (158℃)	1.6	1.7	T0-220AC
G3S12002C	1200	2 (157℃)	1.6	1.7	TO-252
G3S12002D	1200	2	1.6	1.7	T0-263
G3S12002H	1200	2 (153℃)	1.6	1.7	T0-220F

(附注： 3300V 0.6A/1A/2A/3A/5A/50A/1200V50A及单芯封装的管芯均可对模块用户提供)

碳化硅器件选型表

料号	反向重复电压	正向平均电流	正向压降VF (V)		封装
		IF(A)	Tj=25℃		
ID	Vrrm(V)	Tc=160℃	typ	max	Package
G3S12002R	1200	2 (157℃)	1.6	1.7	TO-252左脚悬空
G3S12003A	1200	3 (159℃)	1.46	1.7	T0-220AC
G3S12003C	1200	3 (158℃)	1.46	1.7	TO-252
G3S12003H	1200	3 (150℃)	1.46	1.7	T0-220F
G3S12003R	1200	3 (158℃)	1.46	1.7	TO-252左脚悬空
G3S12005A	1200	5	1.46	1.7	T0-220AC
G3S12005C	1200	5 (159.5℃)	1.46	1.7	TO-252
G3S12005D	1200	5 (163℃)	1.46	1.7	T0-263
G3S12005H	1200	5(145℃)	1.46	1.7	T0-220F
G3S12005P	1200	5 (159℃)	1.46	1.7	TO-247AC-2L
G3S12005R	1200	5 (159.5℃)	1.46	1.7	TO-252左脚悬空
G3S12010A	1200	10 (155℃)	1.55	1.7	T0-220AC
G3S12010C	1200	10 (154℃)	1.55	1.7	TO-252
G3S12010D	1200	10 (157℃)	1.55	1.7	T0-263
G3S12010H	1200	8.5 (125℃)	1.55	1.7	T0-220F
G3S12010M	1200	10 (142℃)	1.55	1.7	T0-220F
G3S12020A	1200	20 (154.5℃)	1.42	1.7	T0-220AC
G3S12020P	1200	20 (155℃)	1.42	1.7	TO-247AC-2L
G3S12050P	1200	50 (155℃)	1.5	1.8	TO-247AC-2L
G3S12040PP	1200	40 (155℃)	1.42	1.7	TO-247AC-2L
G3S12010BM	1200	5* (159℃)	1.46	1.7	TO-247AB-3L
G3S12020B	1200	10* (154℃)	1.55	1.7	TO-247AB-3L
G3S12040B	1200	20* (155℃)	1.42	1.7	TO-247AB-3L
G4S12020D	1200	20 (159℃)	1.42	1.7	T0-263
G5S12002A	1200	2(166℃)	1.36	1.7	T0-220AC
G5S12002C	1200	2(164℃)	1.36	1.7	TO-252
G5S12002H	1200	2(160.5℃)	1.36	1.7	T0-220F
G5S12002R	1200	2	1.38	1.7	TO-252左脚悬空
G5S12002D	1200	2	1.38	1.7	T0-263
G5S12005A	1200	5(161℃)	1.38	1.7	T0-220AC
G5S12005C	1200	5(161℃)	1.38	1.7	TO-252
G5S12005D	1200	5 (159℃)	1.36	1.7	T0-263
G5S12005P	1200	5 (159℃)	1.38	1.7	TO-247AC-2L
G5S12005H	1200	5 (153℃)	1.38	1.7	T0-220F
G5S12008A	1200	8(153℃)	1.45	1.7	T0-220AC
G5S12008C	1200	8(155℃)	1.45	1.7	TO-252
G5S12008D	1200	8(152.5℃)	1.45	1.7	T0-263
G5S12008P	1200	8 (156℃)	1.47	1.7	TO-247AC-2L
G5S12008H	1200	8 (129℃)	1.47	1.7	T0-220F
G5S12008PM	1200	8 (156℃)	1.47	1.7	TO-247AC-2L
G5S12008M	1200	8 (144℃)	1.47	1.7	T0-220F
G5S12010A	1200	10(156℃)	1.39	1.7	T0-220AC
G5S12010P	1200	10 (155℃)	1.4	1.7	TO-247AC-2L
G5S12010C	1200	10(154℃)	1.39	1.7	TO-252
G5S12010D	1200	10(151℃)	1.39	1.7	T0-263
G5S12010PM	1200	10 (155℃)	1.4	1.7	TO-247AC-2L
G5S12010M	1200	10 (137℃)	1.4	1.7	T0-220F

(附注： 3300V 0.6A/1A/2A/3A/5A/50A/1200V50A及单芯封装的管芯均可对模块用户提供)

碳化硅器件选型表

料号	反向重复电压	正向平均电流	正向压降VF (V)		封装
		IF(A)	Tj=25℃		
ID	Vrrm(V)	Tc=160℃	typ	max	Package
G5S12015A	1200	15(155.5℃)	1.4	1.7	T0-220AC
G5S12015L	1200	15 (157℃)	1.39	1.7	TO-247AB-3L
G5S12015PM	1200	15(150.5℃)	1.40	1.7	TO-247AC-2L
G5S12015D	1200	15 (154℃)	1.39	1.7	T0-263
G5S12020A	1200	20 (151℃)	1.45	1.7	T0-220AC
G5S12020H	1200	13 (125℃)	1.45	1.7	T0-220F
G5S12020D	1200	20 (148℃)	1.45	1.7	T0-263
G5S12020U	1200	20 (148℃)	1.45	1.7	T0-263
G5S12020PM	1200	20 (153℃)	1.45	1.7	TO-247AC-2L
G5S12030PP	1200	30 (157℃)	1.47	1.7	TO-247AC-2L
G5S12030PPM	1200	30 (150.5℃)	1.4	1.7	TO-247AC-2L
G5S12040PP	1200	40 (150℃)	1.45	1.7	TO-247AC-2L
G5S12040PPM	1200	40 (150℃)	1.45	1.7	TO-247AC-2L
G5S12050PM	1200	50 (147℃)	1.5	1.7	TO-247AC-2L
G5S12010BM	1200	5* (158℃)	1.36	1.7	TO-247AB-3L
G5S12016BM	1200	8*(153.5℃)	1.45	1.7	TO-247AB-3L
G5S12020BM	1200	10* (153.5℃)	1.39	1.7	TO-247AB-3L
G5S12030BM	1200	15*(150.5℃)	1.4	1.7	TO-247AB-3L
G5S12040BM	1200	20*(150℃)	1.45	1.7	TO-247AB-3L
G5S12040PPM	1200	40(150℃)	1.45	1.7	TO-247AC-2L
G5S12030PMT	1200	30(127℃)	1.53	1.7	TO-247AC-2L
G5S12040PMT	1200	40(128.7℃)	1.5	1.7	TO-247AC-2L
G4S12010LM	1200	10 (154℃)	1.55	1.6	TO-247AB-3L
G4S12010PM	1200	10 (154℃)	1.55	1.6	TO-247AC-2L
G4S12020BM	1200	10* (154℃)	1.55	1.6	TO-247AB-3L
G4S12020PM	1200	20 (155℃)	1.42	1.6	TO-247AC-2L
G4S12040BM	1200	20* (155℃)	1.42	1.6	TO-247AB-3L
G6S12020PT	1200	20 (143℃)	1.44	1.7	TO-247AC-2L
G6S12040BT	1200	20* (143℃)	1.44	1.7	TO-247AB-3L
G5S12010PM	1200	10 (153.5℃)	1.39	1.7	TO-247AC-2L
G5S12020PM	1200	20 (150℃)	1.45	1.7	TO-247AC-2L
G5S12050PM	1200	50 (139℃)	1.43	1.7	TO-247AC-2L
G3S17005A	1700	5 (164℃)	1.35	1.7	T0-220AC
G3S17005C	1700	5 (163℃)	1.35	1.7	TO-252
G3S17005P	1700	5 (163.5℃)	1.35	1.7	TO-247AC-2L
G3S17010A	1700	10 (162℃)	1.33	1.7	T0-220AC
G3S17010P	1700	10 (163℃)	1.33	1.7	TO-247AC-2L
G3S17050P	1700	50 (150℃)	1.6	1.9	TO-247AC-2L
G3S17050PM	1700	50 (150℃)	1.6	1.9	TO-247AC-2L
G3S17010B	1700	5*(125℃)	1.35	1.7	TO-247AB-3L
G3S17020B	1700	10* (163℃)	1.33	1.7	TO-247AB-3L
G3S17020PP	1700	20 (156℃)	1.33	1.7	TO-247AC-2L
G1S3300.6P	3300	0.6 (166.2℃)	1.9	2	TO-247AC-2L
G1S33001P	3300	1 (166℃)	1.8	2	TO-247AC-2L
G1S33002P	3300	2 (163.5℃)	1.85	2	TO-247AC-2L
G1S33003P	3300	3 (163.5℃)	1.7	2	TO-247AC-2L
G1S33005P	3300	5 (155℃)	2.3	3	TO-247AC-2L

(附注：3300V 0.6A/1A/2A/3A/5A/50A/1200V50A及单芯封装的管芯均可对模块用户提供)

>>>联系我们/Contact us

泰科天润半导体科技（北京）有限公司立足于北京和湖南浏阳，建立上海、深圳办事处。美国、欧洲、新加坡、韩国、日本和俄罗斯等地都有代理渠道提供服务支持。未来泰科天润将通过资本实力、资产规模、业务开拓、市场占有率等方面的跨越式发展，加速提升综合实力和市场竞争力，向国内各省市区域和国际市场扩张。



■ 泰科天润半导体科技（北京）有限公司（总部）

地址：北京市顺义区文良街15号1号楼2层东侧(泰科天润)
电话：010-82156177 18210043636
邮箱：qiuqi@globalpowertech.cn
传真：010-82156177

■ 浏阳泰科天润半导体技术有限公司（厂线）

地址：湖南省浏阳市永安镇高新技术产业园永和南路新能源汽车零部件产业园18号
电话：0731 - 81810988转8015 18210043636
邮箱：qiuqi@globalpowertech.cn



泰科天润官网



线上商城



微信公众号